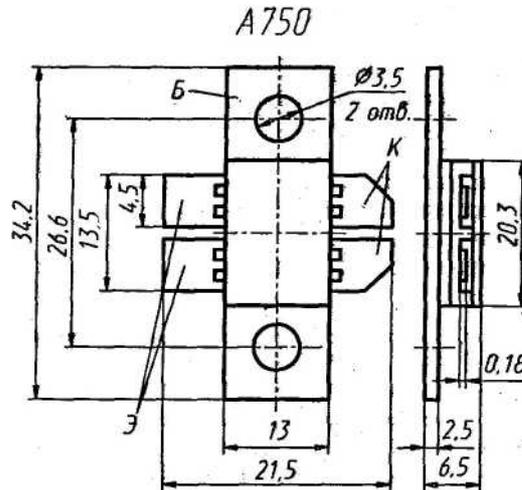


## A750

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* генераторный. Предназначен для применения в широкополосных усилителях мощности, генераторах и умножителях частоты в диапазоне частот 0,9... 1,45 ГГц в схеме с общей базой в непрерывном и импульсном режимах, в том числе в широкополосных устройствах, полосы которых лежат в диапазоне частот 1,2...1,45 ГГц. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



### Электрические параметры

Импульсная выходная мощность на $f = 1,2; 1,3; 1,4$ ГГц при $U_n = 32$ В, $K_{y p} = 6,5$ дБ,	
$\eta_k = 45\%$ , $t_i = 300$ мкс, $Q = 5$ , не менее	125 Вт
Коэффициент усиления по мощности на $f = 1,2; 1,3; 1,4$ ГГц при $U_n = 32$ В, $P_{вых} = 125$ Вт, $K_{y p} = 6,5$ дБ,	
$\eta_k = 45\%$ , $t_i = 300$ мкс, $Q = 5$ , не менее	6,5 дБ
Коэффициент полезного действия коллектора на $f = 1,2; 1,3; 1,4$ ГГц при $U_n = 32$ В, $P_{вых} = 125$ Вт,	
$K_{y p} = 6,5$ дБ, $\eta_k = 45\%$ , $t_i = 300$ мкс, $Q = 5$ , не менее	45%
Выходная мощность на $f = 1,3$ ГГц при $U_n = 28$ В, $K_{y p} = 6$ дБ,	
$\eta_k = 45\%$ , не менее	110 Вт
Коэффициент усиления по мощности на $f = 1,3$ ГГц при $U_n = 28$ В, $R_{вых} = 110$ Вт,	
$\eta_k = 45\%$ , не менее	6 дБ
Коэффициент полезного действия коллектора на $f = 1,3$ ГГц при $U_n = 28$ В, $K_{y p} = 6,5$ дБ,	
$R_{вых} = 110$ Вт, не менее	45%
Обратный ток коллектора при $U_n = 50$ В, не более	150 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3,5$ В, не более	50 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	50 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	3,5 В
Средний ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора:	
при $t_i = 20$ мкс, $Q = 10$	15 А
при $t_i = 100$ мкс, $Q = 10$ или $t_i = 400$ мкс, $Q = 5$	12 А
Постоянный ток базы	4,5 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора	
в динамическом режиме	176 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+175 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус	0,85 °С/Вт
Температура окружающей среды	—60... $T_k = +125$ °С
<sup>1</sup> При $T_k < +75$ °С	$R_k$ ср. макс = 100/0,85, Вт.
При $T_k > +75$ °С	$R_k$ ср. макс = (175 - $T_k$ )/0,85, Вт

Применение транзистора в статическом режиме, в том числе в режиме класса «А», не допускается.

Шероховатость контактирующей поверхности теплоотвод должна быть не более 1,6 мкм, неплоскостность не более 0,01 мм. Минимальное расстояние места пайки выводов о корпуса 3 мм, температура пайки не выше +265 °С. Допускается пайка выводов на расстоянии 1,5 мм, температура пайки выше +150 °С, время пайки не более 8 с. Допускается сварка выводов на расстоянии 1,5 мм при температуре не более +150 °С. Допускается обрезать и изгибать выводы на расстоянии 1,5 мм от корпуса.